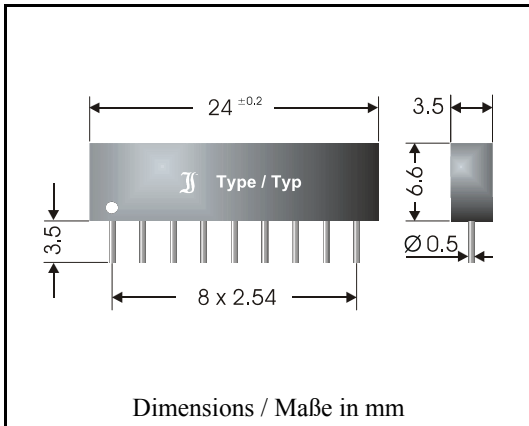
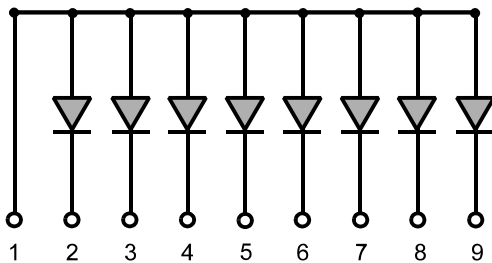


**Small Signal Diode Arrays**

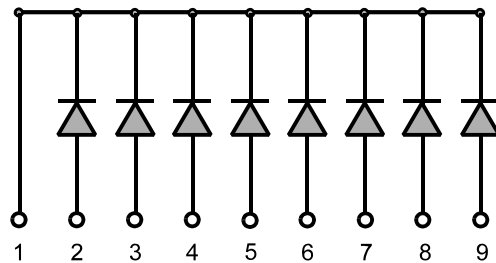
**Dioden Sätze mit Allzweckdioden**



Nominal power dissipation	200 mW
Nenn-Verlustleistung	
Repetitive peak reverse voltage	80 V
Periodische Spitzensperrspannung	
9 Pin-Plastic case	24 x 3.5 x 6.6 [mm]
9 Pin-Kunststoffgehäuse	
Weight approx. – Gewicht ca.	0.6 g
Standard packaging: bulk	see page 22
Standard Lieferform: lose im Karton	s. Seite 22



"DAP": common anodes / gemeinsame Anoden  
"DA4148A": common anodes / gemeinsame Anoden



"DAN": common cathodes / gemeinsame Kathoden  
"DA4148K": common cathodes / gemeinsame Kathoden

**Maximum ratings**

**Grenzwerte**

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung $V_{RRM}$ [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung $V_{RSM}$ [V]
DAN 803 = DA 4148 K	80	80
DAP 803 = DA 4148 A	80	80

Max. average forward rectified current, R-load, for one diode operation only per diode for simultaneous operation	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$I_{FAV}$ 100 mA <sup>1)</sup> $I_{FAV}$ 25 mA <sup>1)</sup>
Dauergrenzstrom in Einwegschtaltung mit R-Last, für eine einzelne Diode pro Diode bei gleichzeitigem Betrieb	$T_U = 25^\circ\text{C}$	$I_{FAV}$ 100 mA <sup>1)</sup> $I_{FAV}$ 25 mA <sup>1)</sup>
Peak forward surge current, 50 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwellen	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$I_{FSM}$ 500 mA

<sup>1)</sup> Leads kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case  
Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten

Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur  
Storage temperature – Lagerungstemperatur

$T_j$  – 50...+150°C  
 $T_s$  – 50...+150°C

**Characteristics**

**Kennwerte**

Forward voltage Durchlaßspannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 10\text{ mA}$	$V_F$	< 1.0 V
Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R = 20\text{ V}$	$I_R$	< 25 nA
Reverse recovery time Sperrverzug	$I_F = 10\text{ mA}$ through/über $I_R = 10\text{ mA}$ to/auf $I_R = 1\text{ mA}$		$t_{rr}$	< 4 ns
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft			$R_{thA}$	< 85 K/W <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Leads kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case  
Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten